

	<h2 style="color: #D9534F;">SI4952DY-T1-E3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI4952DY-T1-E3</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 25V 8A 8-SOIC</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4952DY-T1-E3.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 8824 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI4952DY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 25V 8A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	8824 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	23 mOhm @ 7A, 10V
Leistung - max	2.8W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	680pF @ 13V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 25V 8A 2.8W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A
Basisteilenummer	SI4952

SI4952DY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4952DY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4952DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4952DY-T1-E3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4950DY-T1-E3</b> VISHAY SI4950DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI4949DY-T1-E3</b> VISHAY SI4949DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI4953</b> VISHAY SI4953 VISHAY</p>	 <p><b>SI4952DY</b> VISHAY SI4952DY VISHAY</p>
 <p><b>SI4952DY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 25V 8A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4949EY-T1-E3</b> VISHAY SI4949EY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI4952DY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 25V 8A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4953/TSM4953</b> Original SOP8</p>

### SI4952DY-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4952DY-T1-E3 Datenblatt	SI4952DY-T1-E3-Datenblätter	SI4952DY-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4952DY-T1-E3
SI4952DY-T1-E3 Electronic	SI4952DY-T1-E3 Hersteller	SI4952DY-T1-E3 Komponenten	SI4952DY-T1-E3 Bild	SI4952DY-T1-E3 Aktie	SI4952DY-T1-E3 Teil
SI4952DY-T1-E3 Preis	SI4952DY-T1-E3 Neu	SI4952DY-T1-E3 Original	SI4952DY-T1-E3 garantiert	SI4952DY-T1-E3 RFQ	SI4952DY-T1-E3 Inventar
					SI4952DY-T1-E3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited